

IX-P-9

CHẾ TẠO ZNO TRÊN GRAPHENE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNHETRON DC

Đình Sơn Thạch, Nguyễn Đoàn Thanh Vinh, Dương Đình Lộc, Lê Quang Toại, Trần Huỳnh Liên

Khoa Khoa học Vật liệu, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Tóm tắt

Màng ZnO được phủ trên màng graphene bằng phương pháp phún xạ magnetron DC với các thông số chế tạo như áp suất khoảng 10^{-3} torr, điện thế 315V, dòng 0,15A. Kết quả phân tích X-ray cho thấy màng ZnO phát triển định hướng chủ yếu theo hướng (002). Kết quả phân tích Raman cho thấy xuất hiện các đỉnh đặc trưng của graphene. Do đó có thể kết luận các thông số chế tạo là phù hợp và màng ZnO đã được lắng đọng trên màng graphene bằng phương pháp phún xạ magnetron DC.

FABRICATION ZNO ON GRAPHENE BY SPUTTERING MAGNHETRON DC METHOD

Abstract

ZnO is coated on the graphene films by sputtering magnetron DC with the fabrication parameters such as pressure of about 10^{-3} torr, voltage 315V, current 0.15 A. X-ray analysis results showed that ZnO oriented development along the direction (002). Raman analysis results showed that the characteristic peaks of graphene. Therefore it can be concluded that fabrication parameters are consistent. ZnO film was deposited on the graphene by sputtering magnetron DC.

Email liên hệ: ndtvinh@gmail.com